Енергія електричного поля

Лекції з електрики та магнетизму

Пономаренко С. М.

Зміст



1. Електрична ємність

2. Енергія електричного поля

3. Пондеромоторні сили

Емність провідника



Якщо провідник має заряд q, то його потенціал дорівнює φ .

Якщо заряд збільшити в n разів, то через принцип суперпозиції в nразів збільшиться і робота по переміщенню пробного заряду в полі провідника від його поверхні на нескінченність. Це означає, що в nразів зросте і потенціал. Отже, відношення q/ϕ не повинно залежати від заряду провідника і характеризує сам провідник.

Відповідно можна ввести ємність провідника як: $C = \frac{q}{\omega}$.

$$C = \frac{q}{\varphi}.$$

Якщо маємо систему двох провідників. Нанесемо на один провідник заряд (-q), а на інший — заряд (+q). Різниця потенціалів провідників $\varphi_+ - \varphi_-$ пропорційна заряду q.

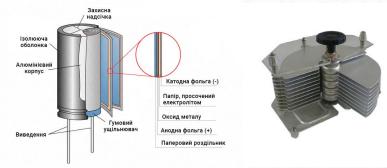
Ємність (взаємна ємність) пари провідників визначається співвідно-

шенням:
$$C=rac{q}{arphi_+-arphi_-}.$$

Конденсатори



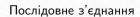
Конденсатор складається з двох металевих пластин— електродів, які називаються також обкладками, між якими знаходиться тонкий шар діелектрика.

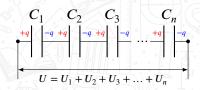


Відео: Заряд та розряд конденсатора

З'єднання конденсаторів

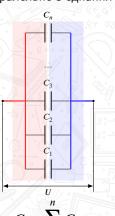






$$\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{C_i}.$$

Паралельне з'єднання



$$C = \sum_{i} C_{i}$$

Задачі



Задача 1

Знайдіть ємність сферичного провідника радіусом R.

Задача 2

Знайдіть ємність плоского конденсатора, відстань між обкладками якого дорівнює d, площа пластин S, простір заповнено дієлектриком з проникністю ε .

Відповідь:
$$C = \frac{\varepsilon S}{4\pi d}$$
.

Задача 3

Знайдіть ємність сферичного конденсатора, радіуси обкладок R_1 та R_2 , простір заповнено дієлектриком з проникністю ε .

Відповідь:
$$C = \frac{\varepsilon R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$
.

Задача 4

Знайдіть ємність циліндричного конденсатора висотою ℓ , радіуси обкладок R_1 та R_2 , простір заповнено дієлектриком з проникністю ε .

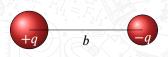
Відповідь:
$$C = \frac{\varepsilon \ell}{2 \ln \frac{R_1}{R_2} d}$$
.

Взаємна ємність двох куль



Задача 5

Знайдемо (взаємну) ємність системи з двох металевих тіл (куль), що мають власні ємності C_1 і C_2 і перебувають на відстані b одна від одної, вважаючи $b\gg C_1,C_2$. Останнє означає, що одна відносно одної кулі можна вважати точковими.



Розв'язок

Нанесемо заряд +q на кулю ємністю C_1 і заряд -q на кулю ємністю C_2 . Запишемо потенціали кульок з урахуванням їхнього взаємного впливу:

$$\begin{cases} \varphi_+ = \frac{q}{C_1} - \frac{q}{b}, \\ \varphi_- = -\frac{q}{C_1} + \frac{q}{b}. \end{cases}$$

Різниця потенціалів $\varphi_+ - \varphi_- = q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} - \frac{2}{b} \right)$, а ємність системи:

$$C = \frac{q}{\varphi_{+} - \varphi_{-}} \approx \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \left(1 + \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \frac{2}{b} \right).$$

Взаємна енергія системи зарядів

8

Щоб зблизити два заряди q_1 і q_2 до відстані r_{12} , потрібно здійснити роботу проти сил поля $A=\frac{q_1q_2}{r_{12}}$, тобто, пара зарядів, яку ми розглядаємо, має енергію $U=\frac{q_1q_2}{r_{12}}$.

Для системи зарядів взаємна енергія дорівнює:
$$U=rac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}rac{q_{i}q_{j}}{r_{ij}}.$$

Потенціал поля в точці знаходження i-го заряду, створюваний усіма зарядами (крім i-го):

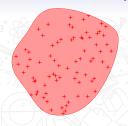
$$\varphi_i = \sum_{j=1 \atop i \neq i}^n \frac{q_j}{r_{ij}}.$$

Потенціальна енергія всієї системи зарядів:

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i} q_i \sum_{\substack{j=1\\i \neq i}}^{n} \frac{q_j}{r_{ij}} = \frac{1}{2} \sum_{i} q_i \varphi_i$$

Електростатична енергія тіл





Якщо заряди розподілені в просторі з об'ємною густиною $\rho(\vec{r})$, а також на поверхнях — з поверхневою густиною $\sigma(\vec{r})$, формула

$$W = \sum_{i} q_{i} \varphi_{i}$$

узагальнюється як:

$$W = \frac{1}{2} \iiint\limits_V \rho(\vec{r}) \varphi(\vec{r}) dV + \frac{1}{2} \iint\limits_S \sigma(\vec{r}) \varphi(\vec{r}) dS.$$

Задачі

Задача 1

Нехай куля радіуса R несе повний заряд Q, що рівномірно розподілений по поверхні. Знайти електростатичну енергію кулі.

Розв'язок

Енерргію знайдемо як:

$$W = \frac{1}{2} \iint_{S} \sigma(\vec{r}) \varphi(\vec{r}) dS = \frac{1}{2} \sigma \frac{Q}{R} 4\pi R^{2} = \frac{Q^{2}}{2R}$$

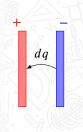
Задача 2

Нехай куля радіуса R несе повний заряд Q, що рівномірно розподілений по об'єму. Знайти електростатичну енергію кулі.

Відповідь:
$$W = \frac{3}{5} \frac{Q^2}{R}$$

Енергія електричного поля в конденсаторі

Зарядимо конденсатора за допомогою перенесення заряду з правої пластини на ліву. Робота з перенесення заряду dq дорівнює $dW=\Delta\varphi dq$, де $\Delta\varphi$ — різниця потенціалів пластин. Оскільки $\varphi=\frac{q}{C}$, то енергія буде дорівнювати:



$$dW = \Delta \varphi dq = \frac{qdq}{C} \implies W = \frac{q^2}{2C} = \frac{C\Delta \varphi^2}{2}.$$

В плоскому конденсаторі поле однорідне $\Delta \varphi = Ed$, ємність плоского конденсатора $C = \frac{\varepsilon S}{4\pi d}$, то для енергії конденсатора отримуємо:

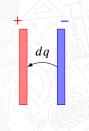
$$W = \frac{1}{2}C\Delta\varphi^2 = \frac{1}{2}\frac{\varepsilon S}{4\pi d}(Ed)^2 = \frac{\varepsilon E^2}{8\pi}V.$$

де V=Sd — об'єм конденсатора. Густина енергії дорівнює

$$w = \frac{\varepsilon E^2}{8\pi}$$
, якщо $D = \varepsilon E \Rightarrow w = \frac{ED}{8\pi}$.

Енергія електричного поля в конденсаторі

Зарядимо конденсатора за допомогою перенесення заряду з правої пластини на ліву. Робота з перенесення заряду dq дорівнює $dW=\Delta\varphi dq$, де $\Delta\varphi$ — різниця потенціалів пластин. Оскільки $\varphi=\frac{q}{C}$, то енергія буде дорівнювати:



$$dW = \Delta \varphi dq = \frac{qdq}{C} \implies W = \frac{q^2}{2C} = \frac{C\Delta \varphi^2}{2}.$$

Енергія конденсатора виражена через характеристики поля (а не заряди):

$$w = \frac{ED}{8\pi}$$

що дозволяє дати нову інтерпретацію результату. Переносником взаємодії зарядів є електричне поле, так що воно і є носієм енергії, передає енергію від одного заряду до іншого. Електричне поле присутнє тільки в об'ємі конденсатора, тож і його енергія локалізована в тих областях простору, де присутнє поле.

Енергія електричного поля (загальне виведення)

Отримана формула для енергії електричного поля для окремого випадку, коли поле однорідне і локалізоване в конденсаторі. Наведемо тепер більш загальний висновок.

При зміні заряду системи на $\delta
ho$, енергія змінюється на величину

$$\delta W = \frac{1}{2} \iiint_{V} \delta \rho(\vec{r}) \varphi(\vec{r}) dV.$$

3 теореми Гаусса $\delta \rho = \frac{1}{4\pi} \operatorname{div} \delta \vec{D}$:

$$\delta W = \frac{1}{8\pi} \iiint\limits_V \frac{1}{4\pi} \operatorname{div} \delta \vec{D} \varphi dV = \frac{1}{8\pi} \iiint\limits_V \left(\operatorname{div} (\delta \vec{D} \varphi) - \delta \vec{D} \cdot \vec{\nabla} \varphi \right).$$

Інтегрування поширене на весь нескінченний простір. Але на великій відстані від системи зарядів поле обертається в нуль. Тому,перший доданок у правій частині $\displaystyle \iiint_V \left(\operatorname{div}(\delta \vec{D} \varphi) \, dV = \iint\limits_{S o \infty} (\varphi \delta \vec{D}) \cdot d\vec{S} = 0 \right)$

У другому доданку врахуємо зв'язок потенціалу та напруженості поля: $\vec{E} = -\vec{\nabla} \varphi$:

$$\delta W = \iiint\limits_{V} \frac{\vec{E} \cdot \delta \vec{D}}{8\pi} dV, \ \Rightarrow \ W = \frac{\vec{E} \cdot \vec{D}}{8\pi}.$$

Власна та взаємна енергія зарядів

Взаємна енергія зарядів:

$$W = \frac{1}{2} \sum \frac{q_i q_j}{r_{ij}}.$$

Енергія поля:

$$W = \int_{V} \frac{E^2}{8\pi} dV.$$

Формула ліворуч може бути як додатною так і від'ємною. Формула праворуч дає значення енергії завжди позитивне, оскільки містить інтеграл від невід'ємної величини.

Поле системи двох зарядів $ec{E} = ec{E}_1 + ec{E}_2$ має енергію:

$$W = \int_{V} \frac{E^{2}}{8\pi} dV = \int_{V} \frac{(\vec{E}_{1} + \vec{E}_{2})^{2}}{8\pi} dV = \int_{V} \frac{E_{1}^{2}}{8\pi} dV + \int_{V} \frac{E_{2}^{2}}{8\pi} dV + \int_{V} \frac{\vec{E}_{1}\vec{E}_{2}}{8\pi} dV$$

Власна енергія зарядів:

$$\int_{V} \frac{E_1^2}{8\pi} dV > 0, \int_{V} \frac{E_2^2}{8\pi} dV > 0.$$

Взаємна енергія:

$$W_{\rm \tiny B3} = \int\limits_{V} \frac{\vec{E}_1 \vec{E}_2}{8\pi} dV \lesseqgtr 0.$$

Теорія

Одним з ефективних прийомів розрахунку сил є метод віртуальних переміщень, у якому обчислюють роботу сил поля $\delta A = F dx$ у разі нескінченно малого зсуву dx, після чого сила знаходиться з рівності $F = \delta A/dx$.

Метод ϵ універсальним, без вияснення причин виникнення сил і автоматично враховувати всі силові взаємодії (електричні та механічні).

14

Енергетичний метод обчислення сил

Теорія

Нехай на провідниках підтримуються постійними заряди, $q={
m const},$ тобто немає зовнішніх джерел енергії.

За таких умов робота δA всіх внутрішніх сил системи під час віртуальних переміщень провідників і діелектриків відбувається за рахунок зменшення електричної енергії dW системи: $\delta A = -(dW)_{q={
m const}}$.

Нехай нас цікавить сила, що діє на дане тіло (провідник або діелектрик). Зробимо нескінченно мале поступальне переміщення dx цього тіла в цікавому для нас напрямку x. Тоді робота шуканої сили F_x визначиться як $\delta A = F_x dx$, звідки:

$$F_x = -\left. \frac{dW}{dx} \right|_{q=\text{const}}.$$

Для обчислення сили за цією формулою не треба підбирати такий режим, за якого обов'язково всі заряди провідників залишалися б постійними. Треба просто знайти приріст dW за умови, що $q=\mathrm{const}$ — це суто математична операція.

Теорія

Нехай тепер на провідниках підтримуються постійними потенціали $\varphi=\mathrm{const.}$ Для цього всистемі є джерело, що постачає заряди і витрачають енергію на здійснення роботи. Із закону збереження енер- $\Delta \varphi$ гії, робота джерела йде на виконання механічної роботи $F_x dx$ та на зміну енергії поля dW:

$$\delta A_{_{\rm D\!M}} = F_{_{\! X}} dx + dW$$

3 іншого боку робота джерела по переміщенню заряду дорівнює $\delta A_{\rm дж}=\delta q\Delta \varphi=\Delta \varphi^2\delta C$, а $dW=\frac{1}{2}\Delta \varphi^2\delta C$, звідки $F_x dx=\frac{1}{2}\Delta \varphi^2\delta C=dW$, тобто:

$$F_{x} = + \left. \frac{dW}{dx} \right|_{\Delta \varphi = \text{const}}.$$

Приклади

Приклад 1

Знайдемо силу тяжіння пластин зарядженого конденсатора.

За умов, коли пластини конденсатора нерухомі, сила \ddot{x} іхнього притягання не залежить від способу обчислення.

Обчислимо силу у випадку $q={
m const.}$ Зміна енергії поля при зміні відстані між пластинами:

$$dW = d\left(\frac{q^2}{2C}\right) = -\frac{q^2}{2C^2}dC, \quad C = \frac{\varepsilon S}{4\pi x}, \quad dC = -\frac{C}{x}dx \implies dW = \frac{q^2}{2Cx}dx.$$

$$dW = \frac{\Delta \varphi^2 C}{2d} dx = \frac{E^2 \mathscr{A}^2 \varepsilon S}{2 \mathscr{A} 4 \pi \mathscr{A}} dx, \quad F_x = -\frac{dW}{dx} = -\frac{\varepsilon E^2}{8\pi} S$$

Знак «мінус» свідчить про те, що пластини притягуються одна до одної.

Приклади

Приклад 1

Знайдемо силу тяжіння пластин зарядженого конденсатора.

За умов, коли пластини конденсатора нерухомі, сила їхнього притягання не залежить від способу обчислення. $x \to x$

Обчислимо силу у випадку $\Delta \varphi = {
m const.}$ Зміна енергії поля при зміні відстані між пластинами:

$$dW = d\left(\frac{C\Delta\varphi^2}{2}\right) = \frac{\Delta\varphi^2}{2}dC, \ C = \frac{\varepsilon S}{4\pi x}, \ dC = -\frac{C}{x}dx \ \Rightarrow \ dW = -\frac{\Delta\varphi^2 C}{2x}dx.$$

$$dW = -\frac{\Delta \varphi^2 C}{2d} dx = -\frac{E^2 \cancel{d^2} \varepsilon S}{2 \cancel{d} 4\pi \cancel{d}} dx, \quad F_x = \frac{dW}{dx} = -\frac{\varepsilon E^2}{8\pi} S$$

Знак «мінус» свідчить про те, що пластини притягуються одна до одної.

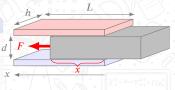
Приклади

Приклад 2

Знайдемо силу, з якою пластина з діелектрика з діелектричною проникністю ε втягується в конденсатор.

Модель

Замінимо конденсатор із частково всунутою в нього пластиною діелектрика двома паралельно з'єднаними конденсаторами, з яких один — вакуумний, а інший заповнений діелектриком.



Ємність системи з двох паралельно з'єднаних конденсаторів дорівнює:

$$C = C_1 + C_2 = \frac{S_1}{4\pi d} + \frac{\varepsilon S_2}{4\pi d}.$$

Сумарна площа пластин конденсаторів незмінна, і можна записати

$$S = S_1 + S_2, S_1 = \left(1 - \frac{x}{L}\right)S, S_2 = \frac{x}{L}S, S = Lh$$

Приклади

Приклад 2

Знайдемо силу, з якою пластина з діелектрика з діелектричною проникністю ε втягується в конденсатор.

Модель

Замінимо конденсатор із частково всунутою в нього d пластиною діелектрика двома паралельно з'єднаними конденсаторами, з яких один — вакуумний, а інщий заповнений діелектриком.

$$C = \frac{S}{4\pi d} \left(1 + (\varepsilon - 1) \frac{x}{L} \right)$$

$$F_x = -\frac{dW}{dx} = -\frac{dW}{dC} \frac{dC}{dx}, \quad \frac{dW}{dC} = -\frac{q^2}{2C^2}, \quad \frac{dC}{dx} = \frac{S}{4\pi d} \frac{\varepsilon - 1}{L}.$$

$$F_x = \frac{q^2}{2C^2} \frac{S}{4\pi d} \frac{\varepsilon - 1}{L} \stackrel{q=CEd}{=} \frac{(\varepsilon - 1)E^2}{8\pi} hd.$$

1. Електрична ємність

- Ємність провідника: $C = \frac{q}{\varphi}$.
- Ємність пари провідників: $C = rac{q}{\Delta \omega}$.
- Послідовне з'єднання конденсаторів: $\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{C_i}$.
- Паралельне з'єднання конденсаторів: $C = \sum_{i=1}^{n} C_i$.
- ullet Ємність плоского конденсатора: $C=rac{arepsilon S}{4\pi d}.$
- ullet Ємність сферичного конденсатора: $C=rac{arepsilon R_1R_2}{R_2-R_1}.$
- Ємність циліндричного конденсатора: $C = \frac{\varepsilon \ell}{2 \ln \frac{R_2}{\varrho}}$.

2. Енергія електричного поля

- ullet Енергія системи зарядів: $U=rac{1}{2}\sum_{i=1}^n\sum_{\substack{j=1\ i
 eq i}}^nrac{q_iq_j}{r_{ij}}.$
- ullet Енергія системи зарядів через потенціал: $W=rac{1}{2}\sum_i q_i oldsymbol{arphi}_i.$
- Енергія тіла $W=rac{1}{2}\mathop{\iiint}\limits_{V}
 ho(\vec{r})\varphi(\vec{r})dV+rac{1}{2}\mathop{\iint}\limits_{S}\sigma(\vec{r})\varphi(\vec{r})dS.$
- ullet Енергія електричного поля в конденсаторі: $W=rac{q^2}{2C}=rac{C\Deltaarphi^2}{2}$
- ullet Енергія через напруженість поля: $W= \iint\limits_V rac{arepsilon E^2}{8\pi} dV$

3. Пондеромоторні сили

- Сила при $q={
 m const.}$ $F_x=-\left(rac{dW}{dx}
 ight)_{q={
 m const.}}=+\left(rac{dW}{dx}
 ight)_{\Delta \varphi={
 m const.}}$
- ullet Сила втягування діелектрика в конденсатор: $F_{\scriptscriptstyle X} = rac{(arepsilon 1)E^2}{8\pi} S_{
 m торця}.$